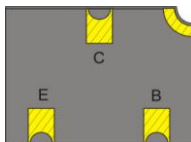


3CG2605UB 型硅 PNP 高频小功率晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 UB 型金属陶瓷封装。
器件具有特征频率高、体积小、重量轻，可靠性高的特点。
器件的静电放电敏感度为 4000V，UB 典型重量 0.04g。



UB 型

2、质量等级及执行标准

G、G+级：Q/RBJ1001QZ，QZJ840611；
JP、JT、JCT：Q/RBJ 30015-2015，GJB33A-1997。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	I_{CM}^{b} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EB0} V	T_{JM} $^{\circ}\text{C}$	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$
3CG2605UB	400	30	-70	-60	-6	200	-65~200
^a P_{tot1} 为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时，按 2.29mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 ^b I_{CM} 为集电极允许耗散功率的范围内，能连续通过发射极的直流电流的最大值。							

4、主要电特性

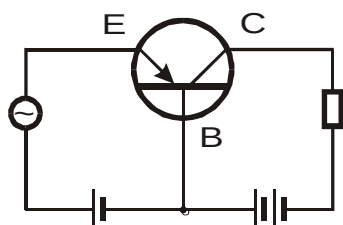
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

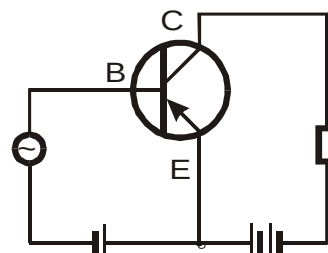
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.1mA$	-70	—	—	V
$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA$	-60	—	—	V
$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1mA$	-6	—	—	V
I_{CBO}	$V_{CB}=-70V$	—	—	10	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=-10V$	—	—	0.1	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-6V$	—	—	10	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-5V, I_C=10mA$	25	—	—	—
$V_{BE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$	-0.7	—	-0.9	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=0.5mA$	—	—	-0.3	V
f_T	$V_{CE}=-5V, I_C=0.5mA, f=30MHz$	30	—	—	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-5V, I_E=0, f=1MHz$	—	—	6	pF

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：



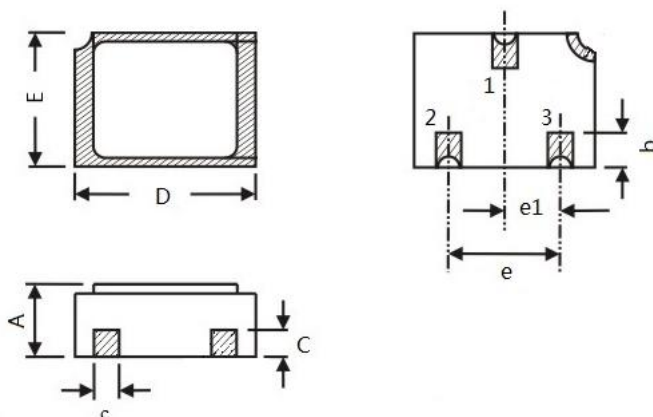
共基极接线法



共发射极接线法

6、外形尺寸

单位为毫米



尺寸符号	数 值	
	最小值	最大值
A	1.12	1.47
b	0.56	0.96
C	0.43	0.89
c	0.35	0.67
D	2.82	3.35
E	2.16	2.74
e	1.76	2.07
e ₁	0.85	1.02

UB 外形尺寸